原码一位乘

乘数:无精气低弱。被除数:双0特气低弱

例
$$X=0.000$$
 $Y=-0.100$ $|X|=00.100$ $|X|=00.100$ $|Y|=0.100$ $|X|=00.000$ $|Y|=0.100$ $|Y|=0.100$ $|Y|=0.100$ $|Y|=0.100$ $|Y|=0.100$ $|Y|=0.000$ $|Y|=0.000$

孙码一位来

校正法 乘数无符号位补码,被乘数:双符号位补码 运算过程同原码一位乘 若乘数 Y< 0, 结果+ L-X)补

```
+X 00.1001
                              Y< 0
   00.1101
DO.0110
                 11'00
                              加州次
                              移机
+000,0000
   00.0110
                 0110
400,0011
+0 00,0000
   00.0011
→ 00,0001
                 1011
+EXM/11.0111
    11,1000
                  1011
[X] * x [] = 1,10001011
 Xx5 = -0.01110101
```

比较法 乘数:单符号位补码+0 被乘数:双特线和码 每次比较 Yn+1-Yn <=0 +0 > 0 + LXJ补 <0 + L-XJ补 <0 +L-XJ补 最后-次(第n+1次) 比较 Yi-ys , 加后不存移

例 X=0.1001 Y=-0.1101 [X]补=00.1001 [-X]补=11.011 [Y]补=1.0011 特点化合被移出 N位 00.000 11.0111 110011 J> 11.1011 +0 00.0000 11.1011 111'001 → 11.1101 加州次 H[X] 00, 1001 形n欠 00,0110 400.0011 011100 +000,000

$$00.001|$$
 $1>00.000|$
 $10111/0$
 11.1000
 1011
 11.1000
 1011
 $11.1000/011$
 $10.1000/011$
 $10.1000/011$

主存容量的扩展

例地址总线 AIS~A。双向数据总线 DIS~D。 控制总线 MREQ 读写 R/W 按字编址 0~1FFFH 为系统程序区,由EPROM芯片组成 从2000H起共16K为用户程序区. 最后4K地址空间为系统程序区

芯片 EPROM: 8K×8位, 16K×8位

SRAM: 16K×1位, 2K×8位, 4K×8位, 8K×8位

		•
8Kx8	8K×8	0000H
EPROM	EPROM	IFFFH
8 K×8	8K×8	2000H
SRAM	SRAM	3FFFH
8k×8	8kx8	4000H
SRAM	SRAM	5FFFH
36K×16空		6000H EFFFH
4K×8	4Kx8	F 000H
SRAM	SRAM	FFFFH



